

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Лагов Петр Борисович
2	Дата рождения (полная)	27 июня 1973 г.
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент (по кафедре)
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 russianspacesystems.ru contact@spacecorp.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научный центр сертификации элементов и оборудования
	Должность	Начальник отдела
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	1. A.Y. Polyakov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, N.B. Smirnov, A.V. Chernykh, E.B. Yakimov, P.B. Lagov et al. 1 GeV proton damage in β -Ga ₂ O ₃ // J. Appl. Phys. – 2021. – Vol. 130 – P. 185701.	
	2. V.M. Kasimova, N.S. Kozlova, O.A. Buzanov, E.V. Zabelina, P.B. Lagov et al. Effect of Electron Irradiation on the Optical Properties of Gadolinium-Aluminum-Gallium Garnet Crystals // J. Surf. Investig. – 2021. – Vol. 15. – No. 6 - P. 1259-1263.	
	3. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, A.I. Kochkova, A.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. Crystal orientation dependence of deep level spectra in proton irradiated bulk β -Ga ₂ O ₃ // J. Appl. Phys. – 2021. – Vol. 130. – P. 035701.	
	4. A.Y. Polyakov, C. Haller, R. Butte, N.B. Smirnov, L.A. Alexanyan, A.I. Kochkova, S.A. Shikoh, I.V. Shchemerov, A.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. Deep Traps in InGaN/GaN Single Quantum Well Structures Grown With and Without InGaN Underlayers // J. Alloys Compd. – 2020. – Vol. 845. – P. 156269.	
	5. L.A. Aslanov, V.B. Zaytsev, V.N. Zakharov, I.K. Kudryavtsev, V.M. Senyavin, P.B. Lagov et al. Nanosilicon stabilized with ligands: effect of high-energy electron beam on luminescent properties // Surf Interface Anal. – 2020. – Vol. 52. – No. 12. – P. 957-961.	

6. A.Y. Polyakov, C. Haller, R. Butte, N.B. Smirnov, L.A. Alexanyan, A.S. Shikoh, I.V. Shchemerov, S.V. Chernykh, P.B. Lagov et al. Effects of 5 MeV Electron Irradiation on Deep Traps and Electroluminescence from Near-UV InGaN/GaN Single Quantum Well Light-Emitting Diodes With and Without InAlN Superlattice Underlayer // J. Phys. D. – 2020. – Vol. 53. – P. 445111.
7. A.Y. Polyakov, N.B. Smirnov, I.V. Shchemerov, A.A. Vasilev, E.B. Yakimov, A.V. Chernykh, A.I. Kochkova, P.B. Lagov et al. Pulsed fast reactor neutron irradiation effects in Si doped n-type β -Ga₂O₃ // J. Phys. D. – 2020. – Vol. 53. – P. 274001.
8. A.Y. Polyakov, C. Haller, N.B. Smirnov, A.S. Shiko, I.V. Shchemerov, S.V. Chernykh, L.A. Alexanyan, P.B. Lagov et al. Effects of InAlN underlayer on deep traps detected in near-UV InGaN/GaN single quantum well light-emitting diodes // J. Appl. Phys. – 2019. – Vol. 126. – P. 115708.
9. P.B. Lagov, V.M. Maslovsky, Yu.S. Pavlov, E.S. Rogovsky, A.S. Drenin, V.A. Bondariev. High-Rate High-Density ICP Etching of Germanium // High Temp. Mater. Process. – 2019. – Vol. 23. – No. 1. – P. 57-70.
10. Ishteev A., Konstantinova K., Muratov D.S., Lagov P. et al. Investigation of structural and optical properties of MAPbBr₃ monocrystals under fast electron irradiation // Journal of Materials Chemistry C. – 2022. – Vol. 10. – No. 15. – P. 5821-5828.
11. Lagov P.B., Maslovsky V.M. Detection of unreliable superluminescent diode chips using gamma-irradiation // Advances in Thin Films, Nanostructured Materials, and Coatings. Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. - P. 309-317.

Статьи опубликованы по результатам исследований, проведенных в НИТУ МИСИС и лаборатории радиационных технологий ИФХЭ РАН

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты